

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成20年11月20日(2008.11.20)

【公開番号】特開2005-64326(P2005-64326A)

【公開日】平成17年3月10日(2005.3.10)

【年通号数】公開・登録公報2005-010

【出願番号】特願2003-294375(P2003-294375)

【国際特許分類】

H 01 L 21/306 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/306 B

H 01 L 21/306 R

【手続補正書】

【提出日】平成20年10月6日(2008.10.6)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

半導体ウェハにデバイスを作成後のスピニエッチング工程で該半導体ウェハのデバイス面をエッチング液から保護するための保護膜の形成方法において、

前記保護膜としてコーティングによって膜形成し得る環化ゴム系の樹脂材を用い、

前記保護膜を、パターニングによって、前記半導体ウェハの周囲より小さく且つ前記デバイス面を保護するように形成することを特徴とする半導体ウェハのデバイス面保護膜形成方法。

【請求項2】

前記樹脂材はフォトレジストであることを特徴とする請求項1に記載のデバイス面保護膜形成方法。

【請求項3】

前記デバイス面と前記保護膜との密着性を向上させるための密着向上層を、前記デバイス面と前記デバイス面保護膜との間に有することを特徴とする請求項1又は2に記載のデバイス面保護膜形成方法。

【請求項4】

前記密着向上層はポリエーテルアミド樹脂を含むことを特徴とする請求項3に記載のデバイス面保護膜形成方法。

【請求項5】

デバイスを形成してなる半導体ウェハの一主面に、請求項1乃至4のいずれか1項に記載のデバイス面保護膜形成方法により保護膜を形成した後に、前記保護膜形成側と反対側の半導体ウェハの主面をスピニエッチングすることを特徴とする半導体ウェハ研磨処理方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0009】

すなわち、本発明の半導体ウェハのデバイス面保護膜形成方法は、半導体ウェハにデバイスを作成後のスピンエッチング工程で該半導体ウェハのデバイス面をエッチング液から保護するための保護膜の形成方法において、

前記保護膜としてコーティングによって膜形成し得る環化ゴム系の樹脂材を用い、

前記保護膜を、パターニングによって、前記半導体ウェハの周囲より小さく且つ前記デバイス面を保護するように形成することを特徴とする。